# 宇宙機用太陽電池カバーガラスのコーティング剤が 帯電に与える影響

○東山直紀,渡邉力夫,三宅弘晃(東京都市大学),高橋眞人,奥村哲平(JAXA)

Influence of space solar cell coverglass coatings for chaging Naoki Higashiyama, Rikio Watanabe, Hiroaki Miyake (Tokyo City University), Masato Takahashi, Teppei Okumura (JAXA)

Key Words: space, charging, solar cell, coverglass, electron beam

# Abstract

Spacecraft are charged under plasma environment and radiation environment in space, and it may lead failures and anomalies of spacecraft when discharge on the spacecraft surface occurs. One of the most important surface materials is cover glass for solar-cells which is a source of an electrical power. The purpose of this paper is to investigate surface-potential characteristics of coverglasses with coatings after electron irradiation. We found that the surface potential on coverglasses becomes positive within a few hours after irradiation. Comparing the surface potential histories of coated coverglass and silica glass revealed that the positive potential of coverglass is due to ionization of metallic atoms in surface coating material. The positive potential is relaxed over several days which will increase a risk of discharge. We conclude it is necessary to select coating materials with lower secondary emission coefficient.

## 1. 研究背景

人工衛星はプラズマ環境及び放射線環境下で帯電 し、帯電に起因する静電放電により搭載機器の故障 や衛星システム全体の機能を喪失する事故を引き起 こした例が多く報告されている<sup>1)</sup>.よって,宇宙機は 設計段階から正確に帯電解析を行う必要がある.人 工衛星電位を決定づけるものは、本体及び表面の絶 縁体に流入出する正負電荷の収支である. 衛星表面 の絶縁体は二次電子放出係数の違いなどから本体と は異なる電位を持つ場合があり、これらの電位差が 大きくなると放電が発生する<sup>2)</sup>.人工衛星表面材料に は、衛星本体表面の熱制御を行うために張り付ける 高分子材料膜や電力源となる太陽電池セルの熱制御 および放射線防護のためのカバーガラスなどがある. 衛星事故の3分の1以上が太陽電池において発生し、 さらに全事故の半数以上が帯電・放電現象に起因す る<sup>3)</sup>ため、太陽電池パネルにおける帯電・放電現象の 特性を理解することは非常に重要である.

図 1 にサブストーム発生時のカバーガラス電位と 衛星構体電位の時間履歴を示す<sup>4)</sup>. 通常の環境では衛 星構体電位 Φ<sub>s</sub>とカバーガラス電位 Φ<sub>cg</sub>はほぼ 0 であ る.サブストーム発生時には高エネルギの電子によ り 2 つの電位は急激に負に陥る.しかし,絶縁体で あるカバーガラス表面では二次電子放出が発生し, 正電荷が蓄積する.この時,太陽電池側面には電界 *E=(Φ<sub>cg</sub>-Φ<sub>s</sub>)/dがかかる*.この式から距離 *d* が小さいほ ど電界は強められることが分かるが,代表的な *d* の 小さい箇所がカバーガラスとインタコネクタ近傍で ある.この箇所が絶縁体,導体,真空の3つが接す るトリプルジャンクションとなり,最も強電界がか かる.このトリプルジャンクションで電界がある一 定の閾値を超えると金属から電界放出が発生し電子 が放出される.この時放出された電子はカバーガラ ス側面に衝突しながら上昇し,更に二次電子を放出 させ側面の正電荷の帯電が加速していく.この帯電 により更に電界も加速的に強められ,更に電子を放 出していく.側面をたたく電子の増加に伴いカバー ガラス側面に吸着していたガスも脱離されていき, ガスの層の中で電離が起き放電に至る.これが放電 発生のメカニズムである.



図1 サブストーム発生時のカバーガラス電位と 衛星構体電位の時間履歴<sup>4)</sup>

現在までに、太陽電池クーポン(試験片)を用い た帯電に関する調査は多く行われている.具体的に は、太陽電池セルの放電による損傷の調査が挙げら れる<sup>5</sup>. また、カバーガラス単体での電子線照射実験 も行われてきたが、二次電子放出係数の評価<sup>6</sup>のため に数 eV 程の低エネルギの電子線を照射する実験が 散見される. 極軌道や静止軌道では、keV オーダー の高エネルギ粒子が支配的な領域であるので、地上 実験においてカバーガラス単体に対して keV オーダ ーの電子線を照射することで、表面電位特性の理解 を深めることができる. 宇宙機の帯電解析を行う上 では、宇宙機表面の電位を知ることは重要である.

#### 2. 研究目的

本研究では真空中でカバーガラスに電子線を照射 し,照射後のカバーガラスの表面電位履歴を取得す ることにより,カバーガラスの表面電位特性を解析 することを目的とする.

## 3. 計測システム

計測システムの構成は、表面電位計、表面電位計 測プローブ、オシロスコープ、ファンクションジェ ネレータ、微小電流計、試料台、真空チャンバ、電 子銃、表面電位測定プローブおよび試料台を移動さ せるための電動リニアドライブ、ペルチェ素子、ペ ルチェコントローラ、白金測温抵抗体、水冷ヒート シンク、冷却水循環装置である.図2にその計測シ ステム構成図を示す.

表面電位計測は次の流れで行われる.まず,真空 チャンバ内の試料台に計測試料を固定し,油回転真 空ポンプおよびターボ分子ポンプを用いて真空引き を行う.真空チャンバ内圧力が 10<sup>4</sup>Pa 以下まで低下 した後,電子銃を用いて試料に電子線を照射し,帯 電させる.電子線照射終了後,真空チャンバ外部か らリニアドライブを操作し,真空チャンバ内部の表 面電位計測プローブを試料前面に移動させ,表面電 位の計測を行う.この表面電位計での測定データを オシロスコープで適宜サンプリングを行い,表面電 位の時間履歴を得る.



図2 計測システム

## 4. 表面電位計測実験

#### 4.1 実験条件

実験対象試料はポリイミドフィルム Kapton<sup>®</sup> 200H, 表面コーティングが施された太陽電池カバーガラス 3種および合成石英ガラスである.表1に実験条件を 示す. No. 2 - 5 が太陽電池カバーガラスである.

## 4.2 ガラス試料について

## 4.2.1 BRR/s 0213<sup>®</sup>

BRR/s 0213<sup>®</sup>は、JDSU (旧 OCLI) 社の製品であり、 表面に BRR コーティングが施されている<sup>7)</sup>. BRR と は Blue and Red Reflective (あるいは Blue and Red Reflector) の略であり、紫外光と赤外光を反射する. これらの長波長光は太陽電池の光電変換に寄与せず、 BRR コーティングで反射することで太陽電池セルの 温度上昇を抑えている.フッ化マグネシウム (MgF<sub>2</sub>) の多層コーティングが施されており、最表面のコー ティング剤は酸化ジルコニウム (ZrO<sub>2</sub>) である.

0213 とは Corning 社のガラスの名称であり, セリ ウム添加ホウケイ酸ガラスを示す. これは ETS-VIII の太陽電池パドルに採用された製品でもある<sup>7)</sup>.

#### 4.2.2 CMG 100 AR<sup>®</sup>および CMX 100 AR<sup>®</sup>

CMG 100 AR<sup>®</sup>およびCMX 100 AR<sup>®</sup>は、Qioptiq(旧 Thales)社の製品であり、表面にARコーティングが 施されている<sup>8</sup>. CMGおよびCMXとはPilkington社の ガラスの名称であり、搭載された太陽電池セルの熱 膨張係数に合わせたガラスを示す<sup>9)</sup>.紫外線、電子、 放射線から太陽電池素子を保護し、低体積抵抗率タ イプである.

ARとはAnti-Reflectionの略であり,反射を防止する. フッ化マグネシウム ( $MgF_2$ )の多層コーティングが 用いられている<sup>10)</sup>.

#### 4.2.3 合成石英ガラス

合成石英ガラスとは、化学的に合成した不純物の 少ない、ほぼ 100%の二酸化珪素(SiO<sub>2</sub>)から成る石 英ガラスを指す.通常、液体材料(SiCl<sub>4</sub>等)から作 られる.光学的な均質性や紫外線域や近赤外線域の 透過特性に優れるが、熔融、成型が困難であるとい う難点がある<sup>11)</sup>.そのため、一般的には金属不純物 などを添加したガラスが用いられることも多い.今 回使用したのは旭硝子株式会社製の合成石英ガラ ス"AQ"である.

#### 4.3 実験結果

図3にKapton<sup>®</sup> 200H と BRR/s 0213<sup>®</sup>の表面電位の 時間履歴を示す.また,図4にKapton<sup>®</sup> 200H と太陽 電池カバーガラス3種に対する表面電位の時間履歴 を示す.どちらも縦軸は試料表面電位V[V]を,横 軸は電子線照射後の経過時間t[hour]を示す.

		No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
Sample		Kapton <sup>®</sup> 200H	BRR/s 0213®	BRR/s 0213®	CMG 100 AR®	CMX 100 AR®	Synthetic Quartz Glass
Sample thickness [µm]		50	100	100	100	100	1.13[mm]
Irradiation	Energy [keV]	15	20	20	20	20	20
	Time [sec]	60	60	60	60	60	60
Current density [µA/cm <sup>2</sup> ]		49	64	64	64	64	64
Vacuum level [Pa]		10-4	10-4	10-6	10-6	10-6	10-6

表1 実験条件



図 3 Kapton<sup>®</sup> 200H と BRR/s 0213<sup>®</sup>の表面電位の 時間履歴



図 4 Kapton<sup>®</sup> 200H と太陽電池カバーガラス 3 種に 対する表面電位の時間履歴

Kapton<sup>®</sup> 200H の表面電位は,計測を開始して数時間は急激に電位が減衰し,その後は減衰が緩やかとなっている.また,太陽電池カバーガラス3種は電子線照射後の数時間のうちに正側の電位に遷移していることがわかる.

当研究室では、これまでに電荷蓄積法<sup>12)</sup>を用いて 宇宙機用材料の体積抵抗率の取得を行ってきた.電 荷蓄積法とは試料表面に誘起した電位の時間履歴を 指数近似し、その減衰時定数から体積抵抗率を求め る手法である.この理論によれば、Kapton<sup>®</sup> 200Hの 減衰時定数は 8.3×10<sup>5</sup>[sec],体積抵抗率は 2.8×10<sup>16</sup>[Ω・ m]となり、体積抵抗率はメーカ公称値<sup>13)</sup>である 10<sup>15</sup>[Ω・m]より一桁大きい値となった.







図6合成石英ガラスと太陽電池カバーガラス3種に 対する表面電位の時間履歴

また、太陽電池カバーガラスの表面電位は正側に 遷移しているため、電荷蓄積法の理論が適用できず 指数減衰曲線近似による体積抵抗率の取得には至っ ていない. 試料 No.2 の BRR/s 0213<sup>®</sup>に注目すると、 電子線照射の約 17 時間後に正電位が最大となり、そ の後は徐々に電位が 0[V]になるように緩和している. この緩和領域が指数近似できると仮定して緩和時定 数を求めたところ、緩和時定数は 8.3×10<sup>5</sup>[sec]となっ た.ここで、緩和時定数とは電荷蓄積法の減衰時定 数と区別するために用いた言葉である.

次に、表面コーティング剤の影響を把握するため に、コーティングの施されていない合成石英ガラス と比較をする.図5に合成石英ガラス"AQ"の表面電 位の時間履歴を示す.また,図6に合成石英ガラス"AQ"と太陽電池カバーガラス3種に対する表面電位の時間履歴を示す.どちらも縦軸は試料表面電位V [V]を,横軸は電子線照射後の経過時間t[hour]を示す.

合成石英ガラス"AQ"の表面電位は、太陽電池カバ ーガラスのように数時間のうちに電位が正側に遷移 することなく、徐々に電位が減衰しているのがわか る.同様に減衰時定数および体積抵抗率を求めたと ころ、合成石英ガラス"AQ"の減衰時定数は 2.2×10<sup>8</sup>[sec]、体積抵抗率は 6.1×10<sup>18</sup>[Ω·m]となった. 製造元である旭硝子株式会社の資料<sup>11)</sup>によれば、体 積抵抗率は 200℃のとき 3×10<sup>10</sup>[Ω·m]、300℃のとき 3×10<sup>8</sup>[Ω·m]とあるが、室温でのデータがなく単純に は比較ができない.そこで、一般的な石英ガラスの 体積抵抗率と比較することにする.文献値<sup>14</sup>より、 石英ガラスの体積抵抗率は室温で 10<sup>16</sup>[Ω·m]とあり、 電荷蓄積法で求めた値は文献値より二桁大きい値と なった.

## 5. 考察

図4および図6より,表面コーティングが施され た太陽電池カバーガラスの表面電位の時間履歴は,3 種類・4試料とも電子線照射の数時間のうちに正側の 電位に遷移している点で類似性がある.また,コー ティング剤の施されていない合成石英ガラスは,正 帯電していないことから,カバーガラスが正帯電す るのは表面コーティング剤が大きく関与していると 考えられる.

カバーガラスが正帯電する理由として以下の仮説 を考えた.電子線照射により、コーティング剤に含 まれる金属元素(Mg)が電離を起こし、二次電子を 放出する.電子線照射直後は、供給され続けていた 入射電子が観測され負電位となる.電子線照射終了 直後に急激な電位減衰が起き、電位が正側に遷移し ているのは、放射線誘起伝導<sup>15)</sup>(Radiation Induced Conductivity: RIC)の効果により電子線照射領域の導 電率が上昇し、試料表面に存在する電子が表面ない しは内部を通過しグランドへと流出し、二次電子の 放出により残された正孔が観測されたためだと考え られる.

ここで、電子の飛程(最大到達深度)について考 えてみる.なお、飛程計算においては(1)式に示すフ ェーザの実験式を利用し算出した.フェーザの実験 式自体はアルミニウムを試料として電子の最大飛程 を実験的に求めた式であるが、今回の試料に付与さ れているコーティング剤である MgF<sub>2</sub>の密度を用い て換算した.

$$R = \frac{0.407E^{1.38}}{\rho} \tag{1}$$

(1)式において, R は飛程[cm], E は照射する電子の エネルギ[MeV],  $\rho$  は透過する物質の密度[g/cm<sup>3</sup>]を示 している.

本実験では、電子の照射エネルギE = 0.020[MeV]、 透過する物質、つまり MgF<sub>2</sub>の密度 $\rho = 3.15[g/cm^3]$ で あるので、これらを(1)式に代入したところ電子の飛 程Rは $R = 5.8[\mu m]$ と求まった.

コーティング剤の付与厚さに関する資料は見つけ ることはできなかったが、多層コーティングされて いることから 1[µm]程であるとしても、コーティング 剤の領域を電子は通過し、ガラス層に到達している と考えられる.

カバーガラスの正電位が緩和されていく理由とし て、ガラス層にトラップされた電子が印加電界に沿 って表面側へと移動し、正孔と結合したためだと考 える.

太陽電池カバーガラスである BRR/s 0213<sup>®</sup>(試料 No.2)の正電位の緩和時定数は 8.3×10<sup>5</sup>[sec]であった が,日数に直すと約十日である.照射エネルギが 20[keV]の電子線を1分間照射するだけで,正電位が 緩和されるのに十日以上かかることがわかる.カバ ーガラスが正帯電することは,衛星電位とカバーガ ラス電位の間で逆電位勾配が形成されやすくなり, 放電に至るリスクを高めてしまう.光学的特性を失 わず,かつ荷電粒子によって電離しにくいコーティ ング剤の選定が必要であると考える.

# 6. まとめおよび今後の予定

高分子材料膜 Kapton<sup>®</sup> 200H,表面コーティングが 施された太陽電池カバーガラス 3 種および合成石英 ガラス"AQ"に対して電子線照射を行い,表面電位を 計測した.これにより以下の結論を得た.

- 表面コーティングが施された太陽電池カバーガラスの表面電位の時間履歴は、4試料とも電子線照射の数時間のうちに正側の電位に遷移している点で類似性がある。
- 電子線照射により、コーティング剤に含まれる金属元素(Mg)が電離を起こし、二次電子の放出により残された正孔が観測され正帯電となる。

これまでの実験では再現性の確認を重視していた ため、パラメータを統一して実験を行ってきた.今 後は実験パラメータを変化させ、パラメータによる 表面電位履歴への影響を明らかにする.実験パラメ ータとして、照射エネルギ、照射時間、電流密度な どを考えている.特に電流密度を変化させる点に関 しては、急務の課題として取り組んでいる.

JAXA の制定した帯電・放電設計標準では基本設計

要求として keV 電子による最悪時電流密度に 1[nA/cm<sup>2</sup>]を統一的に採用している<sup>16)</sup>.当研究室の実 験系では,表1に示すように電子線照射エネルギが 20[keV]の場合で電流密度は64[µA/cm<sup>2</sup>]である.この 値は設計標準の64000倍の値である.電流密度の大 きさが表面電位履歴に与える影響を評価するために も,電流密度を変化(減少)させ実験する必要があ る.

# 参考文献

- H. C. Koons. et al., "The Impact of the Space Environment on Space Systems", Proceedings of the 6th Spacecraft Charging Technology Conference, 2000, Air Force Research Laboratory, pp. 7-11
- M. Cho and H. Fujii, "Review on Charging and Discharging Phenomena in Space Environment: Arcing on High Voltage Solar Array and Future Issues", Aeronautical and Space Sciences Japan, 2003, vol. 51, pp. 140-145
- 豊田裕之ら、"EL イメージングによる太陽電池 セルの劣化評価", Proceedings of the 3rd Spacecraft Environment Symposium, 2007, pp. 99-104
- Nitta. K, "Discharge Phenomena and the Countermeasure for Spacecraft", The journal of the Institute of Electrical Engineers of Japan, 2011, vol. 131, no. 6, pp. 359-362,
- 5) 豊田裕之ら, "プラズマ環境における太陽電池セ ルの放電による劣化", 第 50 回宇宙科学技術連 合講演会, 2006, pp. 1979-1984
- Kawakita, S. et al., "Influence of high energy electrons and protons on secondary electron emission of cover glasses for space solar cells", Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, 2002, 2002. 20th International Symposium on, pp. 84-87
- JDSU, "Solar cell coverglass, radiation-resistant glass"
- Qioptiq Space Technology, "Solar cell cover glasses"
- Kitchen, C.A., "Teflon bonding of solar cell assemblies using Pilkington CMZ and CMG coverglasses-now a production process", Photovoltaic Energy Conversion, 1994, vol. 2, pp. 2058-2061
- Ianno, N.J., "Atomic oxygen induced degradation of MGF2 anti-reflective coatings", Photovoltaic Specialists Conference, 2008. PVSC '08. 33rd IEEE, 2008, pp. 1-5
- 11) 小林重義ら, "合成石英ガラス"AQ"の特性", 旭

硝子研究報告, 1986, vol. 36, no. 1, pp. 149-154

- 12) John R. Dennison et al., "Methods for High Resistivity Measurements Related to Spacecraft Charging", Plasma Science, 2006, vol. 34, pp. 2191-2203
- 13) 東レ・デュポン株式会社, "カプトン総合カタロ グ"
- 14) 国立天文台,"理科年表平成22年(机上版)", 丸善株式会社, 2009, 1041p
- 15) Yang, G.M., Sessler, G.M., "Radiation-induced conductivity in electron-beam irradiated insulating polymer films", Electrical Insulation, IEEE Transactions on, 1992, vol. 27, no. 4, pp. 843-84
- 宇宙航空研究開発機構、"帯電・放電設計標準"、 2010,88p